
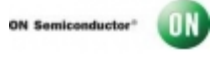



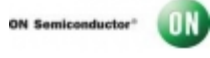
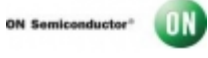
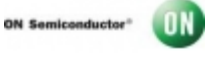
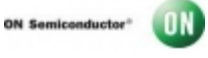
	<h2 style="color: #E67E22;">FCP260N60E</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FCP260N60E
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 600V 15A TO-220
	Datenblätter:  FCP260N60E.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 63010 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP260N60E
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 15A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	63010 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	260 mOhm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 15A (Tc) 156W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)

FCP260N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP260N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP260N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ FCP260N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP25N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCP25N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCP36N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A TO-220-3</p>	 <p>FCP260N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220</p>
 <p>FCP260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 260MOHM TO220</p>	 <p>FCP360N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220 PKG</p>	 <p>FCP290N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>	 <p>FCP25N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 25A TO220-3</p>

FCP260N60E Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP260N60E	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP260N60E Datenblatt	FCP260N60E-Datenblätter	FCP260N60E PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP260N60E
FCP260N60E Electronic	FCP260N60E-Komponenten	FCP260N60E Hersteller	FCP260N60E-Verteiler	FCP260N60E-Bild	FCP260N60E-Teil
FCP260N60E Preis	FCP260N60E Original	FCP260N60E Bild	FCP260N60E garantiert	FCP260N60E Aktie	FCP260N60E Inventar
FCP260N60E Neu		FCP260N60E Original	FCP260N60E garantiert	FCP260N60E RFQ	FCP260N60E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited